

	<p>SIR888DP-T1-GE3</p>
	<p>Hersteller-Teilenummer: SIR888DP-T1-GE3</p>
	<p>Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay</p>
	<p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 25V 40A PPAK SO-8</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	<p>Datenblätter:  SIR888DP-T1-GE3.pdf</p>
	<p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p>
	<p>Lagerzustand: New original, 1000 pcs Stock Available.</p>
	<p>Liefern von: Hong Kong</p>
	<p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>

Spezifikationen

Teilenummer	SIR888DP-T1-GE3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET N-CH 25V 40A PPAK SO-8
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	1000 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	2.2V @ 250µA
Vgs (Max)	±16V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PowerPAK® SO-8
Serie	TrenchFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	3.25 mOhm @ 15A, 10V
Verlustleistung (max)	5W (Ta), 48W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	PowerPAK® SO-8
Andere Namen	SIR888DP-T1-GE3TR
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	5065pF @ 15V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	120nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	25V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 25V 40A (Tc) 5W (Ta), 48W (Tc) Surface
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	40A (Tc)

SIR888DP-T1-GE3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SIR888DP-T1-GE3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SIR888DP-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ SIR888DP-T1-GE3 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>SIR890DP SI SIR890DP SI</p>	 <p>SIR888DP-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 25V 40A PPAK SO-8</p>	 <p>SIR882ADP-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 100V 60A PPAK SO-8</p>	 <p>SIR882DP-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 100V 60A PPAK SO-8</p>
 <p>SIR882DP VISHAY VISHAY QFN-8</p>	 <p>SIR890DP-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 20V 50A PPAK SO-8</p>	 <p>SIR890DP-T1-E3 VISHAY SIR890DP-T1-E3 VISHAY</p>	 <p>SIR890DP-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 20V 50A PPAK SO-8</p>

SIR888DP-T1-GE3 Zugehöriges

Mehr

Schlüsselwort

SIR888DP-T1-GE3 Electronic	SIR888DP-T1-GE3 Datenblatt	SIR888DP-T1-GE3-Datenblätter	SIR888DP-T1-GE3 PDF	Electro-Films (EFI) / Vishay SIR888DP-T1-GE3
SIR888DP-T1-GE3 Preis	SIR888DP-T1-GE3 Hersteller	SIR888DP-T1-GE3 Bild	SIR888DP-T1-GE3 Aktie	SIR888DP-T1-GE3 Teil
SIR888DP-T1-GE3 Neu	SIR888DP-T1-GE3 Original	SIR888DP-T1-GE3 garantiert	SIR888DP-T1-GE3 RFQ	SIR888DP-T1-GE3 Inventar
				SIR888DP-T1-GE3 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr. 509, 5 / F Sing Win-Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hongkong.

Copyright © 2020 YIC International Co., Limited